Влияние водорода на структуру ультрадисперсного алмаза

© А.Е. Алексенский, М.В. Байдакова, А.Я. Вуль, А.Т. Дидейкин, В.И. Сиклицкий, С.П. Вуль

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, 194021 Санкт-Петербург, Россия

(Поступила в Редакцию 20 января 2000 г. В окончательной редакции 18 февраля 2000 г.)

Сообщается о результатах исследования структурного фазового перехода в кластерах ультрадисперсного алмаза (УДА), полученного методом детонационного синтеза. Фазовый переход осуществлялся при отжиге в атмосфере водорода. Исследовались образцы двух типов, так называемого "сухого" и "водного" синтеза, отличающиеся скоростью охлаждения продуктов детонации и, соответственно, структурой оболочки алмазного нанокластера. Показано, что вне зависимости от типа синтеза в диапазоне температур отжига $450-750^{\circ}$ С возрастает относительное содержание алмазной (sp3)-фазы, и это возрастание более существенно в образцах, полученных "сухим" синтезом. Обсуждается модель, объясняющая наблюдаемые процессы структурных превращений. Выдвигается предположение о возможности компактации кластеров УДА в объемные монокристаллы.

Работа выполнена при поддержке Российской программы "Фулерены и атомные кластеры" (проект "Пленка-2"). Один из авторов (Сиклицкий В.И.) был поддержан РФФИ (проект № 98-07-90336) и Государственной российской программой "Физика твердотельных наноструктур" (проект № 97-0003).

Ультрадисперсный алмаз (УДА) представляет собой углеродный кластерный материал с характерным размером кластера около 50 Å. УДА образуется в результате взрыва смеси тринитротолуола и гексогена в условиях детонационной волны при температуре и давлении, соответствующих области термодинамической стабильности алмаза [1–5]. Кластерная структура материала определяется малым (десятки микросекунд) временем детонации.

Результаты последних исследований [6] позволяют представить элементарный кластер УДА в виде ядра с решеткой алмаза размером 40-50 Å, находящегося внутри оболочки, существенно отличающейся по структуре от ядра. Толщина оболочки составляет 4–10 Å и зависит от параметров технологического процесса. Структура оболочки, состоящей из углерода с sp2-гибридизацией связей, определяется условиями синтеза УДА: скоростью охлаждения продуктов детонации и способом последующего выделения алмазной фазы. В модели, предложенной в [6], указывается, в частности, что оболочка неоднородна по степени упорядоченности структурных фрагментов, начиная от непрерывных слоев углерода луковичной формы (onion-like carbon), непосредственно покрывающих алмазное ядро кластера, до малых (несколько десятков атомов) фрагментов графитоподобных (graphene) монослоев, сосредоточенных в периферийных слоях оболочки. Предположение о том, что при малых размерах углеродных кластеров алмаз, а не графит является термодинамически стабильной фазой [7,8], позволяет ожидать в некоторых условиях увеличения соотношения (sp3/sp2) в ходе фазового перехода за счет перехода атомов оболочки в ядро кластера. Однако, как показывают результаты проведенных ранее исследований [3], наоборот, при нагревании УДА в вакууме и в инертной атмосфере фазовый переход алмаз-графит происходит за счет разрушения алмазного ядра и начинается при более низких температурах, чем в объемных кристаллах.

С другой стороны, хорошо известны способы получения алмаза осаждением углерода из газовой фазы при низких давлениях и температурах (CVD). Синтез при этом ведется в атмосфере водорода, который стабилизирует образующуюся алмазную (sp3)-фазу, препятствуя структуризации графитовой (sp2)-фазы, и, возможно, играет роль промежуточного звена при формировании решетки алмаза [9]. В связи с этим представляются интересными исследования изменений структуры оболочки кластеров фазового перехода в УДА при отжиге в атмосфере водорода.

1. Образцы и методика эксперимента

Использовались образцы двух типов, приготовленные из детонационного углерода, полученного с использованием различных способов охлаждения продуктов детонации: газовое (СО₂) охлаждение, так называемый сухой синтез (Dry); водяное охлаждение, так называемый водный синтез (Wet). Исходные материалы, таким образом, различались скоростью охлаждения продуктов детонации и соответственно структурой оболочек кластеров [10].

Очистка (выделение УДА из продуктов детонации) производилась обработкой в водной азотной кислоте 50%-ной концентрации при температуре $240-260^{\circ}$ С. После многократных промывок водой УДА подвергался сушке на воздухе при температуре 200° С, после сушки материал представлял собой порошок с размером частиц $10-100~\mu$ m, что является характерным размером агрегатов из кластеров УДА [1].

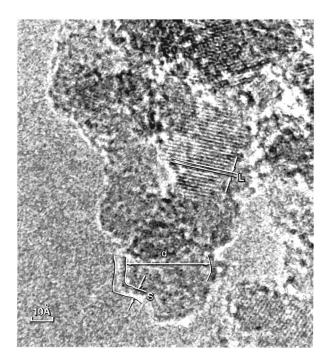


Рис. 1. Микрофотография образца УДА, полученного водным синтезом до отжига.

На рис. 1 приведена электронная микрофотография образца исходного УДА, полученного водным синтезом, выполненная в просвечивающем режиме. Хорошо виден участок агрегата, состоящего из отдельных кластеров. Форма их близка к сферической, характерные размеры практически одинаковы. Участки, заполненные параллельными темными линиями, соответствуют виду на плоскости (111) алмазных ядер кластеров. Характерная сетчатая структура образуется из-за наложения двух и более кластеров с разными направлениями решеток. Наблюдаемое расстояние между плоскостями ($L = 2.05 \,\text{Å}$) может быть использовано как масштабная мера для изображения и позволяет непосредственно определить размер кластера, который составляет $d = 52 \,\text{Å}.^1$ Структура наблюдаемого агрегата — плотная (характерно отсутствие видимых пустот между границами кластеров), отсутствуют также отдельно расположенные кластеры, что находится в соответствии с представлениями о структуре УДА [2,6]. Наблюдаемая на приведенном изображении толщина оболочки кластеров составляет $S = 4-7 \,\text{Å}$, оболочка обладает относительно гладкой поверхностью и, как и предполагалось выше, не имеет выраженной упорядоченной структуры.

Для исследования структурных изменений в оболочке УДА кластеров при отжиге в атмосфере водорода использовались одинаковые порции неуплотненного материала. Процесс отжига производился в кварцевом реак-

торе с внешним нагревом при атмосферном давлении в потоке водорода, пропущенного через палладиевый фильтр. Образцы загружались в холодный реактор, доводились до выбранного значения температуры, выдерживались в изотермических условиях в течение 3 часов и затем охлаждались в режиме выключенного нагревателя. Время разогрева до заданной температуры не превышало 20 min, время охлаждения — 2 часа.

Для изучения структуры использовался традиционный метод — анализ зависимости интенсивности рентгеновского рассеяния и дифракции ($\lambda=1.542\,\mathrm{\AA}$) от волнового вектора в диапазоне углов $10^\circ < 2\theta_\mathrm{Br} < 80^\circ.$

2. Результаты эксперимента и их обсуждение

На рис. 2, *а* представлены результаты измерений угловых зависимостей рентгеновской дифракции на материале образцов УДА, полученного сухим синтезом, до и

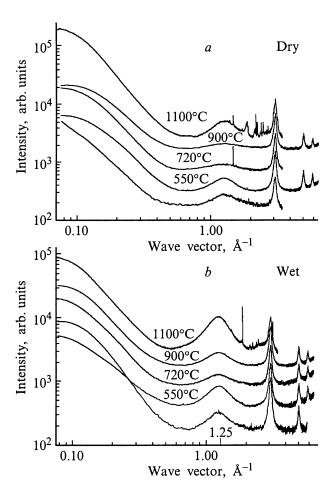


Рис. 2. Зависимости интенсивности рентгеновского рассеяния и дифракции от волнового вектора образцов УДА, полученных сухим (a) и водным (b) синтезом, после отжига в атмосфере водорода при различных температурах. Заметные узкие максимумы на кривых для температур отжига $T=1100^{\circ}\mathrm{C}$ соответствуют дифракции на кристаллизовавшихся примесях.

¹ Приведенное на рис. 1 изображение получено сканированием фотоотпечатка с последующей компьютерной обработкой для повышения контрастности. Электронная микрофотография была получена на просвечивающем электронном микроскопе высокого разрешения группой В.Л. Кузнецова (СО РАН).

после отжига в водороде при различных температурах. Соответствующие результаты для УДА водного синтеза приведены на рис. 2, b. Во избежание наложения кривые значений интенсивности рассеянного рентгеновского излучения сдвинуты относительно друг друга.

Наблюдаемые при углах $2\theta_{\rm Br} = 43.9^{\circ}$ и $2\theta_{\rm Br} = 75.3^{\circ}$ интенсивные симметричные максимумы соответствуют отражениям (111) и (220) от решетки алмаза. Полуширины этих максимумов соответствуют размеру области когерентного рассеяния около 45 Å в приближении сферических частиц (как для материала сухого, так и водного синтеза). Это утверждение хорошо согласуется с известным размером ядер кластеров УДА [2,6] и определенным по электронным микрофотографиям. Форма максимумов (соотношение интенсивностей и симметрия) сохраняются до температуры отжига $T = 900^{\circ}$ С. Согласно представлениям, развитым в [6], это свидетельствует о сохранении структуры и размеров алмазных ядер кластеров. На всех приведенных зависимостях отчетливо наблюдается интенсивное диффузное рассеяние (гало) с максимумом вблизи $2\theta_{\rm Br}=17^{\circ}$. Это гало связывается с рассеянием рентгеновского излучения на структурных элементах оболочки кластера [10]. форма и положение на кривой рассеяния определяется форм-фактором единичного структурного элемента оболочки УДА. Этот элемент— группа из шести атомов углерода в состоянии *sp*2-гибридизации, расположенных в виде плоского кольца (так называемый углеродный гексагон) с характерными размерами диагоналей 2.46 и 2.84 Å (соответствующие величины волнового вектора 1.28 и 1.11 $Å^{-1}$). Углеродный гексагон входит в состав как сплошных внутренних слоев оболочки алмазного ядра (onion like carbon), так и малых фрагментов плоскостей графита ("ароматических кластеров" в терминологии [6]), составляющих наружные слои оболочки. Интенсивность гало определяется как общим количеством углеродных гексагонов, так и степенью их упорядоченности в оболочках кластеров. Поскольку, как отмечалось выше, до температуры $T = 900^{\circ}$ С состояние алмазной фазы (sp3) в образце остается неизменным, оказывается возможным использовать интенсивность любого дифракционного максимума (например, $q = 3.05 \,\text{Å}^{-1}$ плоскостей (111) алмазной решетки) в качестве масштабной меры для наблюдения за интенсивностью гало при $q=1.20-1.25\,{\rm \AA}^{-1}$, связанного с (sp2)-фазой, в зависимости от температуры отжига.

На рис. 3, a представлена зависимость обратной относительной интенсивности рассматриваемого гало ($I_{3.05}/I_{1.20}$) от температуры отжига в атмосфере водорода образцов УДА, полученных сухим и водным синтезом. Аппроксимация выполнена стандартным построением полинома второй степени. Для сравнения на рис. 3, b приведены аналогичные кривые для образцов УДА сухого и водного синтеза после отжига в аналогичном режиме в нейтральной атмосфере (в аргоне), построенные по данным работы [2].

Из приведенных зависимостей следует, что при отжиге в нейтральной атмосфере и в водороде образцов УДА,

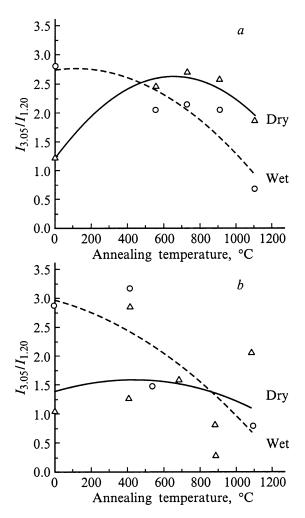


Рис. 3. Относительные интенсивности гало, связанного с рассеянием на элементах ароматического кластера, для образцов УДА после отжига при различных температурах в атмосфере водорода (a) и аргона (b).

полученного водным синтезом, с возрастанием температуры отношение $I_{3.05}/I_{1.20}$ монотонно уменьшается (яркость гало возрастает). При отжиге в водороде УДА, полученного сухим синтезом, зависимость имеет характерный максимум в области температур $600-800^{\circ}$ С.

Монотонное возрастание яркости рассматриваемого гало при сохранении относительной доли алмазной фазы, наблюдаемое на образцах, полученных водным синтезом, в диапазоне температур отжига $T=900^{\circ}\mathrm{C}$ можно объяснить упорядочением структуры sp2-оболочки кластеров за счет отжига. Это связано с тем, что за счет быстрого охлаждения продуктов детонации при водном синтезе sp2-оболочка алмазных кластеров не успевает приобрести упорядоченную структуру. На данный факт указывает и то, что в образцах УДА до отжига отношение $I_{3.05}/I_{1.20}$ значительно выше у образцов УДА, полученных водным синтезом. Сравнение результатов отжига в водороде и аргоне указывает на отсутствие в случае водного синтеза заметного влияния состава атмосферы на изменение структуры оболочки. Этот факт подтвер-

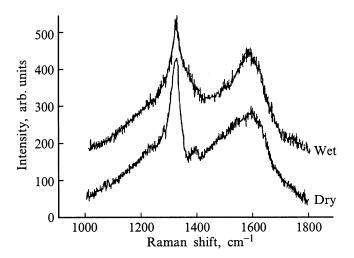


Рис. 4. Спектры комбинационного рассеяния образцов УДА после отжига в водороде при $T=720^{\circ}\mathrm{C}$.

ждается тем, что на спектре комбинационного рассеяния света (КРС), измеренном после отжига при $T=720^{\circ}\mathrm{C}$ (рис. 4), наряду с яркой линией нанокристаллического алмаза при $1322\,\mathrm{cm}^{-1}$ отчетливо видны признаки упорядоченной (sp2)-фазы (интенсивные полосы при 1350 и $1580\,\mathrm{cm}^{-1}$).

Исходя из рассматриваемых зависимостей, можно сделать вывод, что структура оболочки кластера УДА, полученного сухим синтезом, существенно отличается от структуры оболочки кластера УДА водного синтеза. По-видимому, это следует из того, что при медленном охлаждении (сухом синтезе) оболочка кластеров УДА успевает приобрести упорядоченную структуру. Подтверждением этого является слабая зависимость относительной интенсивности $I_{3,05}/I_{1,20}$ от температуры отжига в инертной атмосфере (рис. 3, b). В случае отжига в атмосфере водорода наблюдается заметное снижение относительной интенсивности гало ($I_{3.05}/I_{1.20}$ имеет выраженный максимум при $T = 700-800^{\circ}$ C). При более высоких температурах интенсивность гало снова возрастает. Можно предполагать, что в области температур $T = 700 - 800^{\circ}$ С за счет действия водорода происходит разрушение структуры sp2-оболочки При этом возможно снижение абкластеров УДА. солютной массы оболочки за счет образования СН4, как это имеет место при осаждении алмазных пленок из газовой фазы (CVD) (хотя в этом случае водород находится в атомарном состоянии) [9]. Не исключен и частичный переход углерода из оболочки в ядро с промежуточным образованием углеводородов (аналогично CVD-процессу). На разрушение структуры (sp2)-фазы указывает и вид спектра КРС, измеренного на образце, полученном сухим синтезом после отжига в водороде. Как видно из рис. 4, практически отсутствует полоса при $1350\,\mathrm{cm}^{-1}$, связанная с упорядоченной (sp2)-фазой.

Увеличение интенсивности гало при $T > 900^{\circ}$ С, очевидно, связано с началом образования (sp2)-фазы в

виде слоев onion-like на поверхности алмазных ядер при их разрушении [11].

Обнаруженные нами при температурах отжига $600-800^{\circ}$ С в водороде снижение содержания (sp2)-фазы и (или) ее разупорядочение в УДА, сопровождаемое перестройкой структуры оболочки кластеров, позволяет предполагать возможность образования значительных по объему поли- и монокристаллов алмаза за счет преобразования углерода оболочек кластеров из (sp2)в (sp3)-фазу. Этот процесс непосредственно наблюдался авторами работы [12] при облучении onion like carbon электронами. Нами в процессе отжига УДА в водороде также наблюдалось образование кристаллов с размерами до 0.1 mm. По всей видимости, этот эффект связан с непосредственной компактацией кластеров УДА в объемные монокристаллы. О подобном результате сообщалось и в работе [13]. С другой стороны, в УДА при повышенных температурах в ряде случаев наблюдается обратный переход sp3-sp2 (графитизация) [3], а результаты экспериментов с образованием в УДА кристаллов оказались плохо воспроизводимыми. Это означает, что равновесие между (sp2)- и (sp3)-фазами в кластерах УДА может определяться и другими факторами, в частности примесями металлов, которые могут играть роль катализаторов при образовании (sp3)-фазы.

Авторы благодарят В.Л. Кузнецова за электронные микрофотографии образцов УДА и В.Ю. Давыдова за измерения спектров КРС и полезные обсуждения.

Список литературы

- А.И. Лямкин, Е.А. Петров, А.П. Ершов, Г.В. Сакович, А.М. Ставер, В.М. Титов. ДАН 302, 3, 611 (1988).
- [2] А.Е. Алексенский, М.В. Байдакова, А.Я. Вуль, В.Ю. Давыдов, Ю.А. Певцова. ФТТ 39, 6, 158 (1997).
- [3] V.L. Kuznetsov, A.L. Chuvilin, Yu.V. Butenko, I.Yu. Malikov, V.M. Titov. Chem. Phys. Lett. 222, 343 (1994).
- [4] N.R. Greiner, D.S. Phillips, J.D. Johnson, F. Volk. Nature 333, 440 (1988).
- [5] Odd E. Andersson, B.L.V. Prasad, Hirohiko Sato, Toshiaki Enoki, Yoshihiro Hishiyama, Yutaka Kaburagi, Masanori Yoshikawa, Shunji Bandow. Phys. Rev. B58, 24, 16388 (1998).
- [6] А.Е. Алексенский, М.В. Байдакова, А.Я. Вуль, В.И. Сиклицкий. ФТТ **41**, *4*, 740 (1999).
- [7] P. Badziak, W.S. Verwoerd, W.P. Ellis, N.R. Greiner. Nature 343, 244 (1990).
- [8] M.Y. Gamarnik. Phys. Rev. **B54**, 3, 2150 (1996).
- [9] Synthetic Diamond: Emerging CVD Science and Technology/ Ed. by Karl E. Spear, John P. Dismukes. John Wiley and Sons Inc. (1993). 430 p.
- [10] М.В. Байдакова, А.Я. Вуль, В.И. Сиклицкий, Н.Н. Фалеев. ФТТ 40, 4, 776 (1998).
- [11] V.L. Kuznetsov, I.L. Ziberberg, V.U. Butenko, A.L. Chuvilin. J. Appl. Phys. 86, 2, 863 (1999).
- [12] Y. Lytovich, F. Banhart. Appl. Phys. Lett. 74, 5, 659 (1999).
- [13] R. Roy, H.S. Dewan, P. Rawindranathan. J. Mater. Chem. 3, 6, 685 (1993).